

导体静电平衡的条件  $\vec{E}_{\text{内}} = \vec{E}_0 + \vec{E}' = 0$

导体静电平衡时，导体是等势体，表面是等势面。

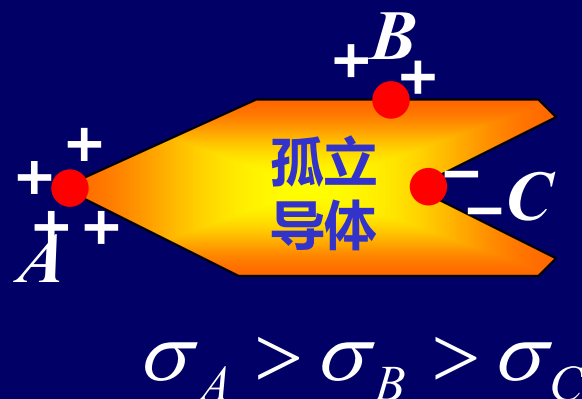
导体的内部处处不带电，净电荷只分布在导体表面。

$$\vec{E}_{\text{表}} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{n}$$

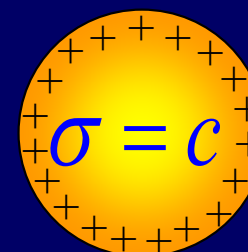
## 3. 处于静电平衡的孤立带电导体电荷分布

由实验可得以下定性的结论：

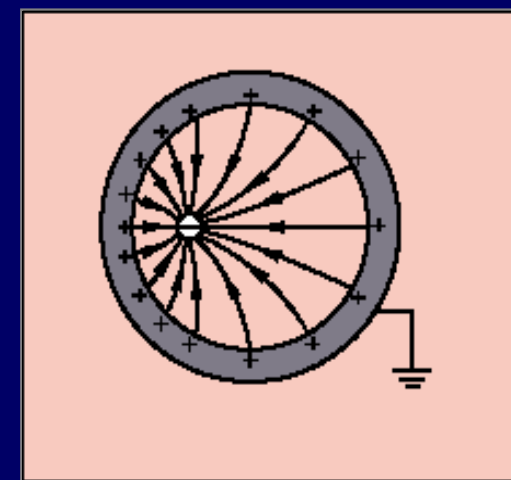
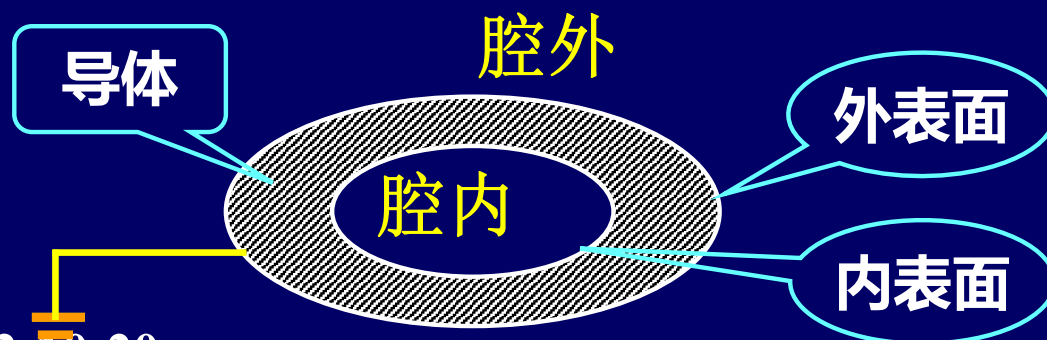
$$\sigma \propto \frac{1}{\rho}$$



孤立带电  
导体球



## 4. 静电屏蔽(腔内、腔外的场互不影响)



**例** 两平行且面积相等的导体板,  $S \gg d^2$

两板的带电量分别为  $q_A$ ,  $q_B$

**求** 静电平衡时两板各表面的电荷面密度

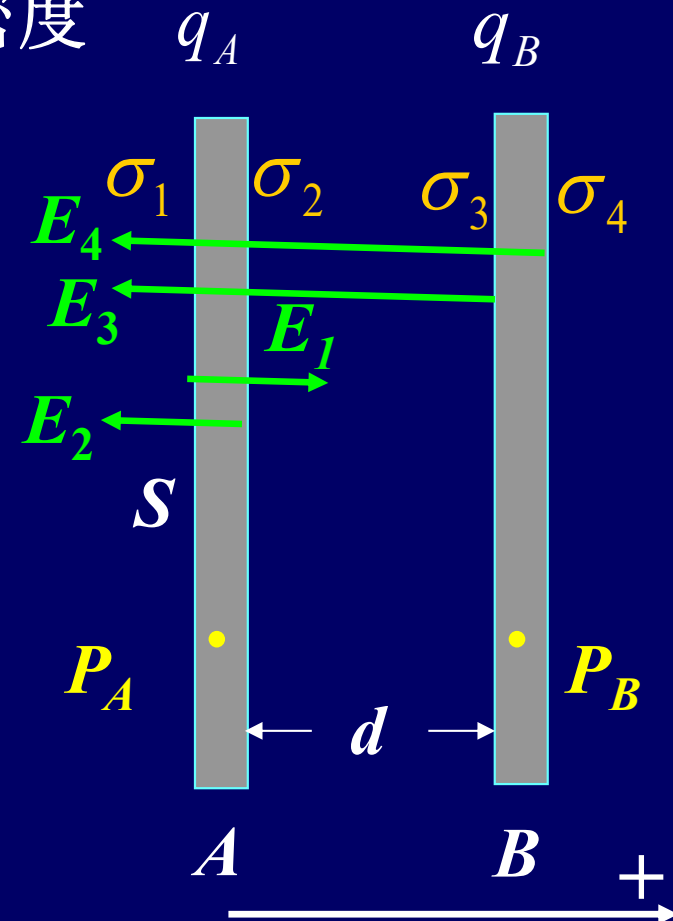
**解**  $\sigma_1 S + \sigma_2 S = q_A \quad (1)$

$$\sigma_3 S + \sigma_4 S = q_B \quad (2)$$

$$E_{PA} = \frac{\sigma_1}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_2}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_3}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_4}{2\epsilon_0} = 0 \quad (3)$$

$$E_{PB} = \frac{\sigma_1}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma_2}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma_3}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_4}{2\epsilon_0} = 0 \quad (4)$$

$$\sigma_1 = \sigma_4 = \frac{q_A + q_B}{2S} \quad \sigma_2 = -\sigma_3 = \frac{q_A - q_B}{2S}$$



### 三. 孤立导体的电容

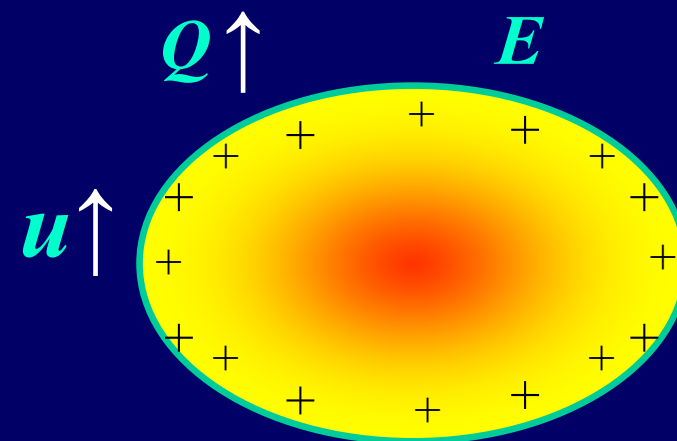
#### 1. 孤立导体的电容

孤立导体的电势  $u \propto Q$

$$C = \frac{Q}{u}$$

孤立导体的电容

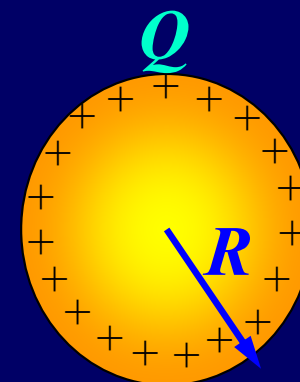
单位: 法拉(F)



求半径为  $R$  的孤立导体球的电容.

电势为  $u = \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0 R}$

电容为  $C = 4\pi \varepsilon_0 R$

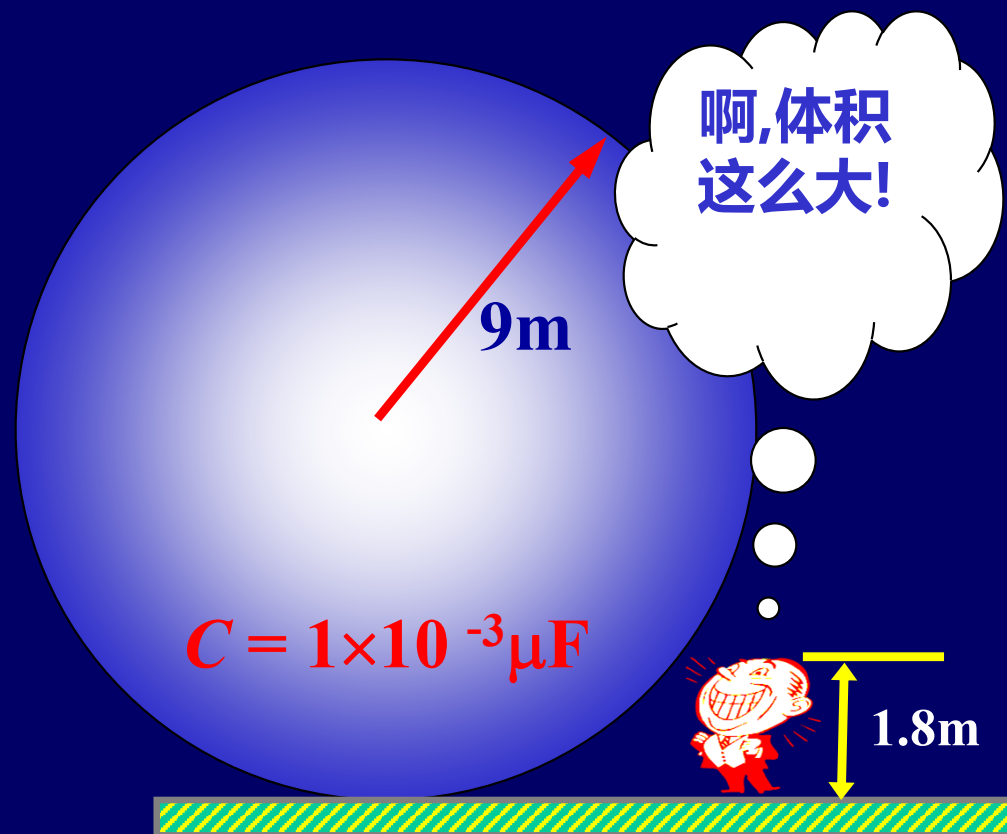


$$C = 4\pi\epsilon_0 R$$

若  $C = 1 \times 10^{-9} \text{F}$  , 则  $R = ?$

$$1 \mu\text{F} = 10^{-6} \text{F}$$

$$1 \text{pF} = 10^{-12} \text{F}$$



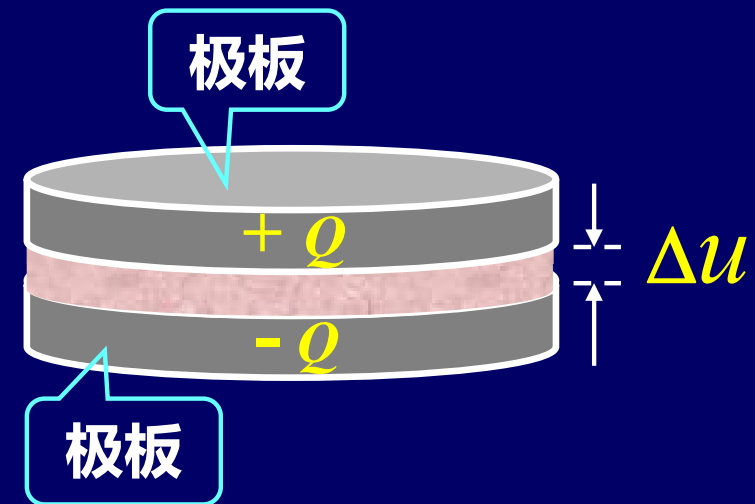
## 四. 电容器的电容

1. 电容器: 被介质隔开的两个相距很近的导体构成的系统。

2. 电容器的电容

两极板带电  $\pm Q$

$$C = \frac{Q}{\Delta u}$$



- 电容器电容的大小取决于极板的形状、大小、相对位置以及极板间介质。
- 表征电容器存储电荷能力的强弱。

## 3. 电容器电容的计算

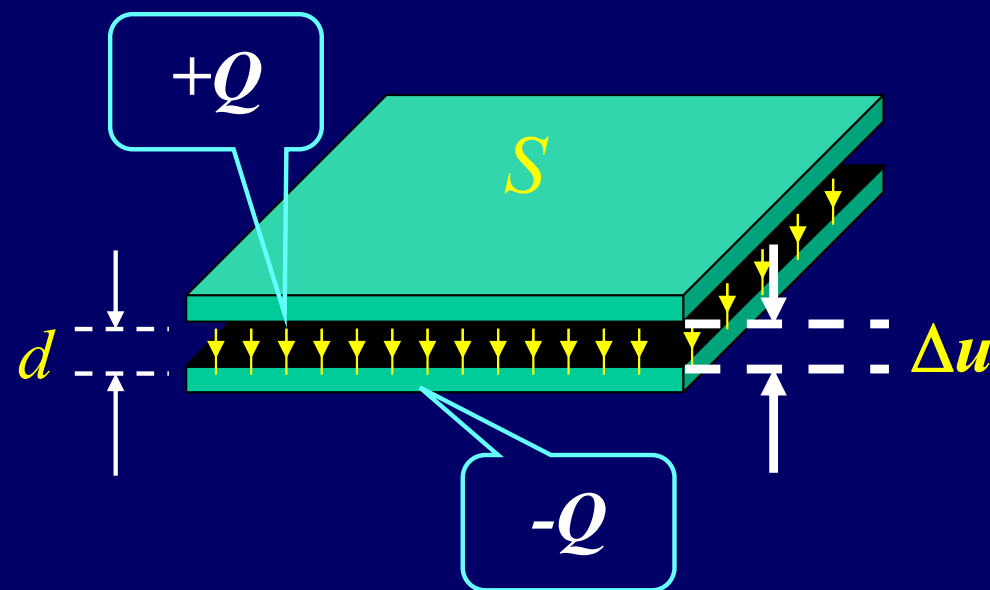
$$\pm Q \longrightarrow \vec{E} \longrightarrow \Delta u \longrightarrow C = \frac{Q}{\Delta u}$$

## (1) 平行板电容器

$$S \gg d^2$$

$$\Delta u = Ed = \frac{Qd}{S\epsilon_0}$$

$$C = \frac{Q}{\Delta u} = \frac{\epsilon_0 S}{d}$$



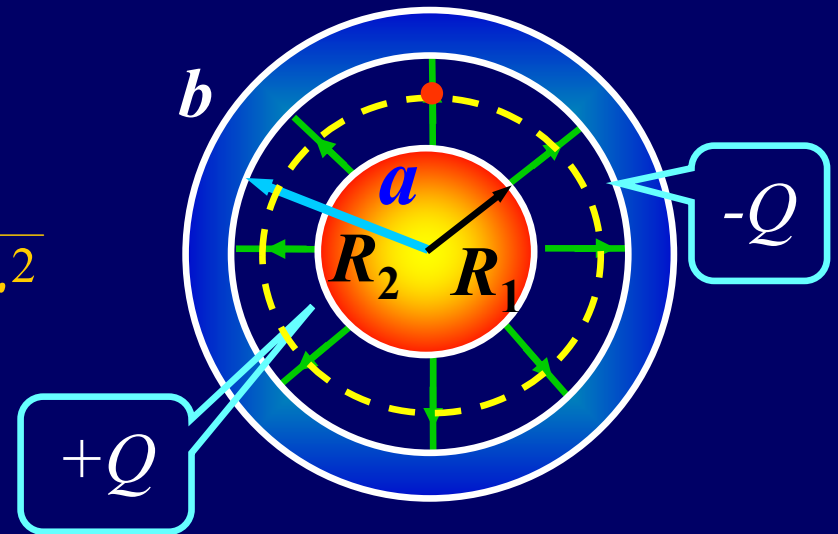
## (2) 球形电容器

$$4\pi r^2 E = \frac{Q}{\varepsilon_0} \quad \longrightarrow \quad E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

$$\Delta u = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} dr$$

$$= \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \left( \frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

$$C = \frac{Q}{\Delta u} = \frac{4\pi\varepsilon_0 R_1 R_2}{R_2 - R_1}$$





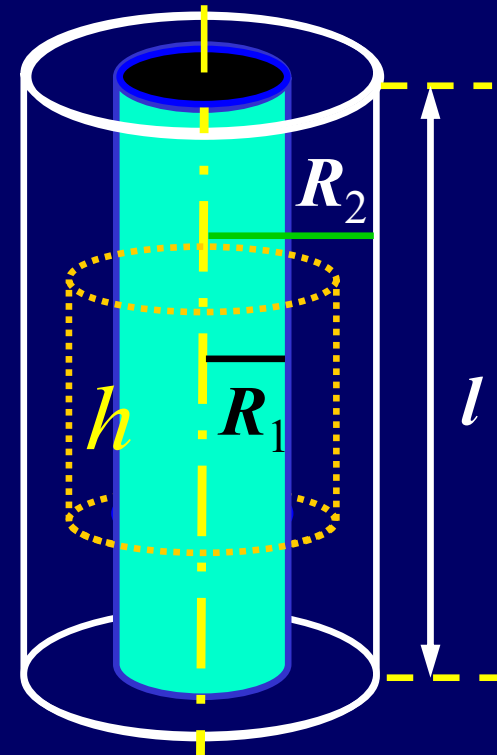
(3) 柱形电容器  $l \gg R_2 - R_1$

$$2\pi r h E = \frac{Q h}{\varepsilon_0 l}$$

$$E = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 r l} \quad (R_1 < r < R_2)$$

$$\Delta u = \int_{R_1}^{R_2} \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 l r} dr = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 l} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

$$C = \frac{Q}{\Delta u} = \frac{2\pi\varepsilon_0 l}{\ln(R_2/R_1)}$$



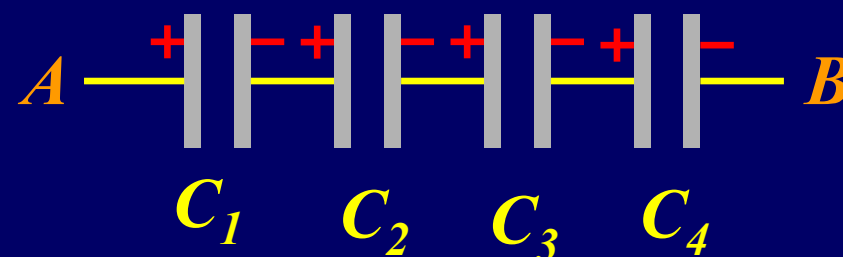
## 4. 电容器的串并联

## (1) 电容器串联

$$u_{AB} = u_1 + u_2 + u_3 + u_4$$

$$= \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2} + \frac{Q}{C_3} + \frac{Q}{C_4}$$

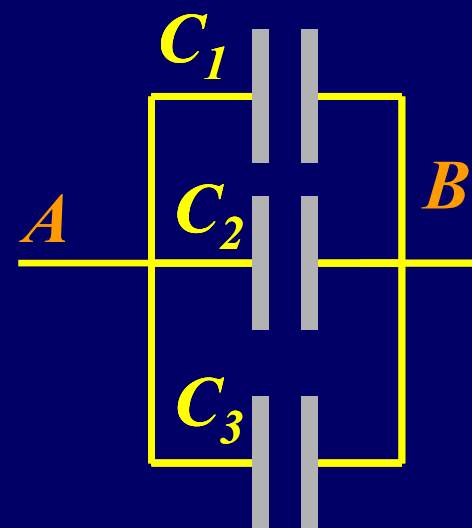
$$C_{\text{串}} = \frac{Q}{u_{AB}} = \left( \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \frac{1}{C_4} \right)^{-1}$$



电容越小分压越大

## (2) 电容器并联

$$C_{\text{并}} = \frac{(q_1 + q_2 + q_2)}{u_{AB}} = C_1 + C_2 + C_3$$



- 电容器的应用：

储能、振荡、滤波、移相、旁路、耦合等。

- 电容器的分类

形状：平行板、柱形、球形电容器等

介质：空气、陶瓷、涤纶、云母、电解电容器等

用途：储能、振荡、滤波、移相、旁路、耦合电容器等。

70  
厘米



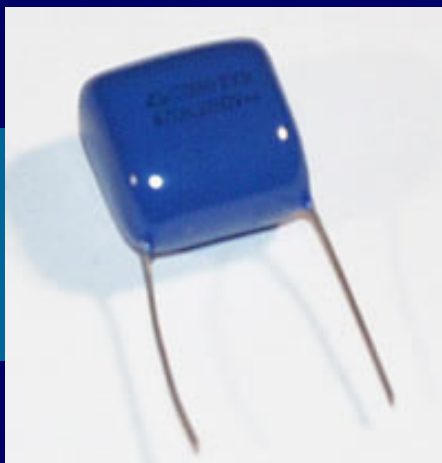
高压电容器(20kV 5~21 $\mu$ F)  
(提高功率因数)

12  
厘米



聚丙烯电容器  
(单相电机起动和连续运转)

2.5  
厘米



涤纶电容  
(250V 0.47 $\mu$ F)



陶瓷电容器  
(20000V 1000pF)

2.5  
厘米



电解电容器  
(160V 470  $\mu$ F)

## 10.8 电场能量

以平行板电容器为例，来计算电场能量。

设在时间  $t$  内，从  $B$  板向  $A$  板迁移了电荷  $q(t)$

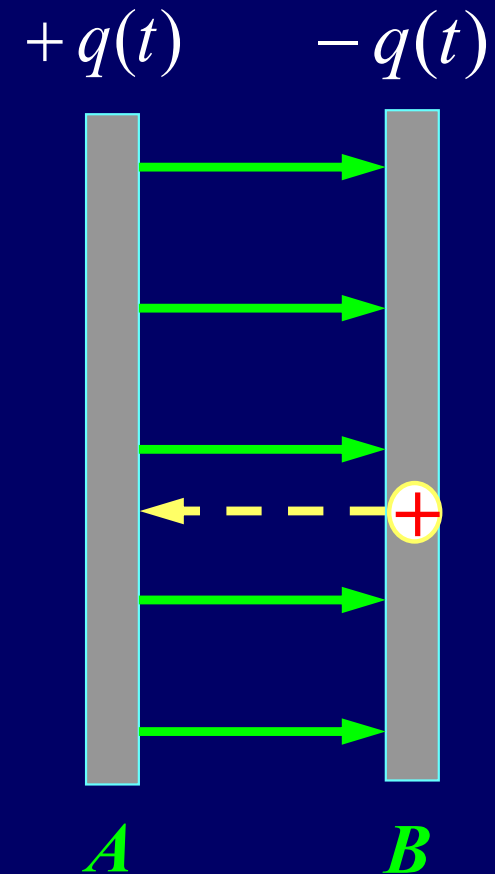
$$u(t) = \frac{q(t)}{C}$$

再将  $dq$  从  $B$  板迁移到  $A$  板需做功

$$dA = u(t) dq = \frac{q(t)}{C} dq$$

极板上电量从  $0$  到  $Q$  作的总功为

$$A = \int dA = \int_0^Q \frac{q(t)}{C} dq = \frac{Q^2}{2C}$$



$$W = A = \frac{Q^2}{2C} \xrightarrow{Q=CU} = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2}QU$$

忽略边缘效应，对平行板电容器有

$$U = Ed \quad C = \frac{\epsilon_0 S}{d}$$

$$W = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2 Sd = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2 V$$

能量密度

$$w = \frac{W}{V} = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2$$

(适用于所有电场)

不均匀电场中

$$dW = w dV$$

$$W = \int_V dW = \int_V \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2 dV$$

**例** 已知带电导体球，半径为 $R$ ，带电量为 $Q$

**求** 它所产生的电场中储藏的电场能量

**解**

$$E_1 = 0 \quad E_2 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

取体积元  $dV = 4\pi r^2 dr$

$$W = \int_R^\infty \frac{1}{2} \epsilon_0 E_2^2 dV = \int_R^\infty \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 R}$$

$$W = \frac{Q^2}{2C} \quad \longrightarrow \quad C = 4\pi\epsilon_0 R$$

